

КТ602БМ

Транзисторы кремниевые планарные структуры n-p-n.

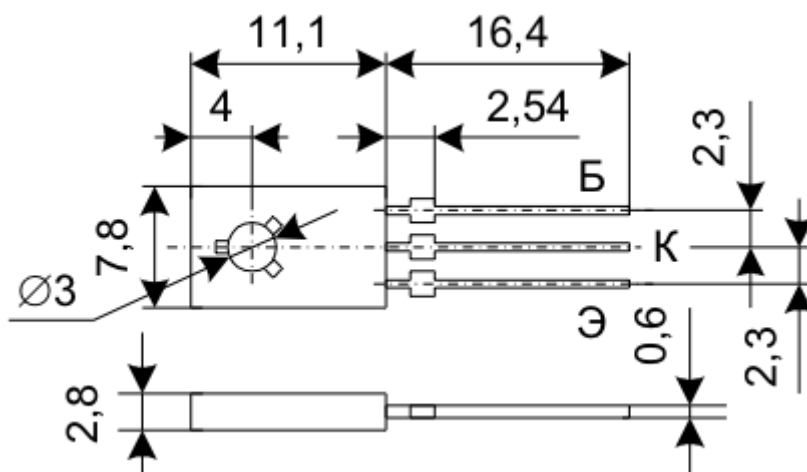
Предназначены для генерирования и усиления сигналов.

Транзисторы выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов не более 1 г.

Технические условия: ЩБ3.365.037 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора КТ602БМ:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб}=10$ В, $I_э=10$ мА : 50... 200;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ: не менее 150 МГц;
- t_k - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 300 пс;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кбо} = 120$ В: не более 70 мкА;
- C_k - Емкость коллекторного перехода: не более 4 пФ;
- $U_{кб\ max}$ – Максимальное постоянное (импульсное) напряжение коллектор-база: 120 (160) В;
- $U_{кэг\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм: 100 В;
- $U_{эб\ max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 5 В;
- $I_k\ max$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 75 мА;
- I_k и $t_{им}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора при $t_i \leq 1$ мкс: 500 мА;
- $P_k\ max$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,85 Вт;
- $P_k\ t\ max$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: не более 2,8 Вт;
- t_n - Температура p-n перехода: не более 120°C;
- $t_{окр}$ – Температура окружающей среды: -60...+125°C.